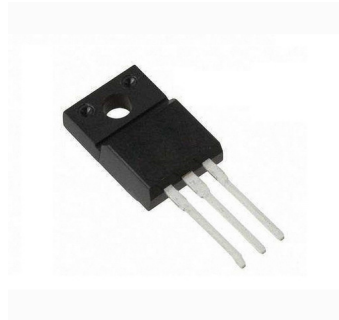


Transistor Mosfet FQPF4N60C 600V 4A

Codigo: **113789**



Descripción

El FQPF6N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Transistor de polaridad: canal N
- Voltaje de ruptura de la fuente de drenaje: 600V
- Voltaje de ruptura de la fuente de la puerta: +/- 30V
- Corriente de drenaje continua: 4 A
- Fuente de drenaje de resistencia RDS (encendido): 1,5 ohmios
- Configuración: Individual
- Temperatura máxima de funcionamiento: + 150 C
- Estilo de montaje: Agujero pasante
- Paquete/Estuche: TO-220F
- Embalaje: Tubo
- Tiempo de caída: 45 ns
- Transconductancia directa gFS (máx./mín.): 4,2 S
- Temperatura mínima de funcionamiento: - 55 C
- Disipación de potencia: 44 W
- Tiempo de subida: 70 ns
- Cantidad del paquete de fábrica: 50
- Tiempo de retardo de apagado típico: 40 ns